

КТ 8174 А,Б

Мощный составной высоковольтный Дарлингтон-транзистор

Кремниевые планарные N-P-N мощные высоковольтные переключательные транзисторы выполненные по схеме Дарлингтон в металлокерамическом корпусе предназначены для работы в мощных ключевых устройствах и другой аппаратуре.



Максимальные электрические характеристики

Наименование параметра, единицы измерения	Букв. обознач.	Норма	
		КТ 8174 А	КТ 8174 Б
Максимально-допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В ($R_{\text{бэ}} = 10 \text{ Ом}$)	$U_{\text{кэг max}}$	700	600
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{\text{кб max}}$	500	400
Максимально- допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{\text{эб max}}$	7	7
Максимально - допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{\text{к max}}$	40	40
Максимально - допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{\text{ки max}}$	63	63
Максимально - допустимый постоянный ток базы, А	$I_{\text{б max}}$	7	1
Максимально - допустимый импульсный ток базы, А	$I_{\text{би max}}$	30	2
Максимально- допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт ($T_{\text{корп}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $U_{\text{кэ}} = 100\text{В}$)	$P_{\text{к max}}$	160	160
Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	$T_{\text{пер max}}$	150	150

Электрические характеристики при $T=25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Букв. обознач	2Т 8174 А		2Т 8174 Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА ($U_{\text{кэо}} = 500\text{В}$) ($U_{\text{кэо}} = 400\text{В}$)	$I_{\text{кэо}}$		10.0		2.0
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА	$I_{\text{кэг}}$		10.0		

$(U_{кэг}=700В, R_{эб} = 10 \text{ Ом})$ $(U_{кэг}=600В, R_{эб} = 10 \text{ Ом})$					2.0
Обратный ток эмиттера, мА $(U_{эб}=2 \text{ В})$	$I_{эбо}$		300		300
Статический коэффициент передачи тока $(U_{кэ}=10 \text{ В}, I_{к}=25 \text{ А})$ $(U_{кэ}= 5 \text{ В}, I_{к}=20 \text{ А})$	$h_{21э}$	50		100	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В $(I_{к}=25 \text{ А}, I_{б}=1 \text{ А})$ $(I_{к}=20 \text{ А}, I_{б}=0,4 \text{ А})$	$U_{кэ \text{ нас}}$		2.5		2.0
Напряжение насыщения база-эмиттер, В $(I_{к}=25 \text{ А}, I_{б}=1 \text{ А})$ $(I_{к}=20 \text{ А}, I_{б}=0,4 \text{ А})$	$U_{бэ \text{ нас}}$		3.0		2.5
Граничное напряжение, В $(I_{к}=300\text{мА}, L=25\text{мГн})$	$U_{кэ \text{ огр}}$	500		400	

Временные характеристики

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Букв. обознач	2Т 8174 А		2Т 8174 Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Время включения, мкс $(U_{кэ}=300В, I_{к}=25А, I_{б1}=1А),$ $(U_{кэ}=300В, I_{к}=20А, I_{б1}=0,4А)$	$t_{вкл}$		2.0		2.0
Время рассасывания, мкс $(U_{кэ}=300В, I_{к}=25А, I_{б1}=1А, I_{б2}=-,5А)$ $(U_{кэ}=300В, I_{к}=20А, I_{б1}=0,4 А, I_{б2}=-0,8А)$	$t_{рас}$		10.0		10.0
Время спада, мкс $(U_{кэ}=300В, I_{к}=25А, I_{б1}=1А, I_{б2}=-2,5А)$ $(U_{кэ}=300В, I_{к}=20А, I_{б1}=0,4 А, I_{б2}=-0,8А)$	$t_{сп}$		4.0		2.5
Прямое напряжение диода, В $(I_{пр}=25 \text{ А})$	$U_{пр}$		2.5		2.5